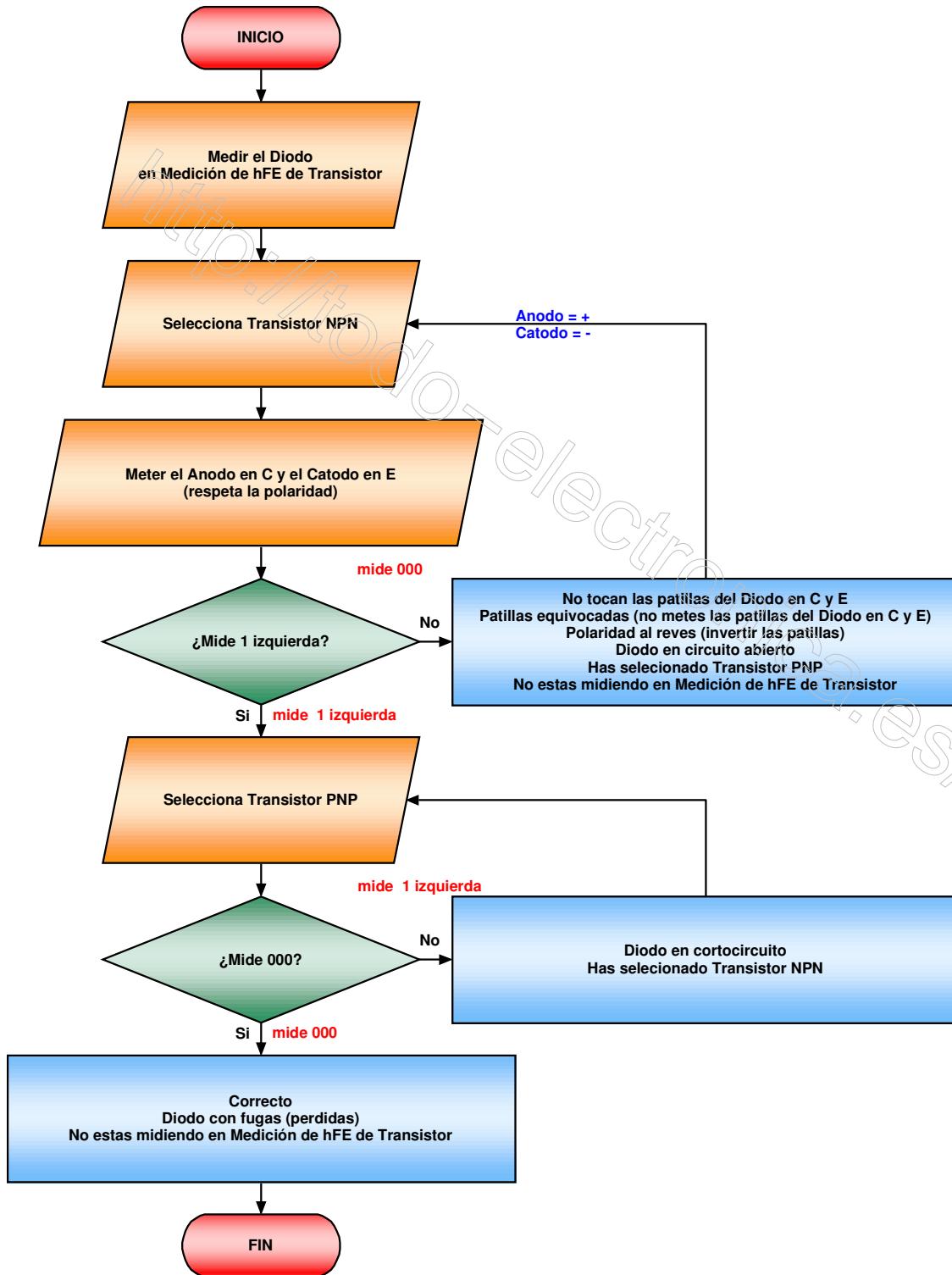


Comprobación de Diodos midiendo hFE de Transistor con un Polímetro Digital MÉTODO 1



Notas:

No válido para Transistor de Germanio (Ge).

Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.

Rango: 0-1000

Condiciones de medición.

Ib = 10 uA, Vce = 2.8 V

1 izquierda = sobrerang

000 = circuito abierto.

2 (NMR) - 7 (PMD) - 3

$$C(NPN) = E(PNP) = +3V$$

$$E(NPN) = C(PNP)$$

En Medición de hFE de Transistor: un 1. a la izquierda = sobre rango o cortocircuito y 000 = circuito abierto

Notas:
No válido para Transistor de Germanio (Ge).

Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.

Rango: 0-1000

Condiciones de medición.

Ib = 10 uA, Vce = 2.8 V

1 izquierda = sobrerango o cortocircuito.

000 = circuito abierto.

2 (NPN) 5 (PNP) 3 V

$$C(NPN) = E(PNP) = +3$$

$$E \text{ (NPN)} = C \text{ (PNP)}$$

V₄'

